

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

#2 Priority  
4/27/02  
O.P.C.I.D.

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日  
Date of Application:

2000年10月30日

出願番号  
Application Number:

特願2000-334938

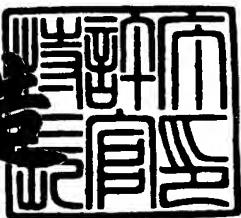
出願人  
Applicant(s):

日本電気株式会社

2001年 7月27日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3066500

【書類名】 特許願  
 【整理番号】 74610514  
 【提出日】 平成12年10月30日  
 【あて先】 特許庁長官殿  
 【国際特許分類】 G02F 1/136  
                   G02F 1/1335  
                   G02F 1/1343

## 【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内  
 【氏名】 松本 公一

## 【特許出願人】

【識別番号】 000004237  
 【氏名又は名称】 日本電気株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100084250  
 【弁理士】  
 【氏名又は名称】 丸山 隆夫  
 【電話番号】 03-3590-8902

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007250  
 【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1  
 【物件名】 図面 1  
 【物件名】 要約書 1  
 【包括委任状番号】 9303564

【プルーフの要否】 要

【請求項7】 前記液晶層に前記電界を印加する電極層を形成する基板側に遮光層を有し、

前記遮光層は、前記基板に垂直な方向で前記絶縁層にオーバーラップしていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記遮光層は、前記電極層であることを特徴とする請求項7記載の液晶表示装置。

【請求項9】 面内で横方向に電界が印加される横方向電界型の液晶表示装置の製造方法において、

第1の透明絶縁性基板と第2の透明絶縁性基板との層間に液晶層を設ける工程と、

画素領域を形成するブラックマトリックス層を設ける工程と、

前記画素領域の中に色層を設ける工程と、を有し、

前記ブラックマトリックス層と前記色層との中央領域の間が高抵抗化されていることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項10】 前記高抵抗化は、

前記ブラックマトリックス層と前記色層とが基板に垂直な方向にオーバーラップしていないことを特徴とする請求項9記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 前記高抵抗化は、

前記ブラックマトリックス層と前記色層との間に絶縁層が介設されていることを特徴とする請求項10記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項12】 前記ブラックマトリックス層と前記色層とを被覆するオーバーコート層を設ける工程を有し、

前記絶縁層は、前記オーバーコート層の一部により形成されることを特徴とする請求項11記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項13】 前記絶縁層は、

前記色層を形成する第1の材料と異なる他の色層により形成される第2の材料で形成され、

前記第2の材料の比抵抗が前記第1の材料の比抵抗よりも高いことを特徴とする請求項11または12記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項14】 前記絶縁層は、

前記液晶層の一部であることを特徴とする請求項11から13のいずれか1項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項15】 前記液晶層に前記電界を印加する電極層を形成する基板側に遮光層を設ける工程を有し、

前記遮光層は、前記基板に垂直な方向で前記絶縁層にオーバーラップしていることを特徴とする請求項9から14のいずれか1項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項16】 前記遮光層は、前記電極層であることを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、横方向電界が印加される液晶表示装置及びその製造方法に関し、特にスイッチング素子として薄膜電界効果型トランジスタを用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、高品位の画質を備える液晶表示技術として、アクティブマトリクス型表示装置が知られている。このアクティブマトリクス型表示装置は、薄膜電界効果型トランジスタ（以下、TFTと称す）が画素のスイッチング素子として用いられている。このようなアクティブマトリクス型表示装置は、薄型、軽量及び低消費電力であると共に、スキャン数に依存せずに鮮明なコントラストと高速表示が可能であることから、携帯型コンピュータ、省スペース・デスクトップ型コンピュータ等のモニタとして幅広く用いられている。

【0003】

また、高画質化のためには、視野角特性の向上が求められる。この視野角特性の向上のためには、横方向電界が利用されている。例えば、特許第2986757号の「電気光学的表示装置及び液晶切換素子」に横方向電界の印加技術が開示

されている。

#### 【0004】

図9は、従来の横方向電界型アクティブマトリクス型表示装置の正面断面図である。図9において、従来の横方向電界型のアクティブマトリクス型表示装置は、対向配置される第1偏光板101と第2偏光板102との間で、第1透明絶縁性基板103が第1偏光板101に接合され、第2透明絶縁性基板104が第2偏光板102に接合されている。第1透明絶縁性基板103と第2透明絶縁性基板104との間で、色付け層（カラーフィルタ層：以下CF層と称す）105が第1透明絶縁性基板層103に接合され、電界印加層106（TFT層）が第2透明絶縁性基板104に接合されている。CF層105と電界印加層106との間には、液晶層107が介設されている。

#### 【0005】

電界印加層106は、第1電極層108と第2電極層109とから形成され、第1電極層108には複数・画素電極110が基板面に平行に配置されて設けられ、第2電極層109には複数・対向電極111が基板面に平行に配置されて設けられている。複数・画素電極110の内の1つと複数・対向電極111の内の1つは、基板面に略平行に対向して横方向（基板面に垂直な方向）の電界を形成し、液晶層107に横方向電界が印加される。

#### 【0006】

このような横方向電界電圧を受ける液晶層107の液晶は、その異方軸（ダイレクタ）の向きが変化して、第1偏光板101と第2偏光板102との間の光透過率が「0」でなくなるように制御される。以上のような制御方法は、ダイレクタが基板内で回転することにより、非常に広い視野角から見て階調反転のない良好な画像を得られる。

#### 【0007】

上述される従来の横方向電界型のアクティブマトリクス型表示装置は、電界印加層106に接合する第2透明絶縁性基板104に対向する第1透明絶縁性基板103側に電極のような導電層が設けられていないので、ブラックマトリックス層112と色層113とから形成されているCF層105に電荷の集積が起こる

## 【0008】

このように第1透明絶縁性基板103が電気的に浮いている基板全体には、内部に印加される様々な電位の影響を受け、ブラックマトリックス層112の電位が変動して共通電位とは異なる電位になって、図9に示されるように、ブラックマトリックス層112の次に抵抗が低い色層113を介して表示部位に電流114が流れ、図10に示されるような等価回路が形成されることになる。

## 【0009】

図10に示される等価回路は、ブラックマトリックス層112と色層113との間の容量結合によって、各画素の表示領域の色層113に電荷の蓄積が生じる。このような電荷の蓄積は、残像現象を引き起こす要因になっていた。

## 【0010】

図11は、公知の単位画素の断面図である。図11によれば、電荷は、ゲート電極層の電界（負）によりブラックマトリックス層7に注入された後、色層8にも注入されるため、コントラスト低下や残像発生の要因になっていた。

## 【0011】

このような電荷の蓄積を防止する従来例1として、特開平10-073810号公報の「液晶表示装置」には、ブラックマトリックス自体を非常に高抵抗化することにより、当該ブラックマトリックスから色層に流れる電流を抑制する技術が開示されている。

## 【0012】

また、従来例2として、特開平09-269504号公報の「液晶表示素子」には、ブラックマトリックスを逆に低抵抗化することにより、それを共通電極と等電位に保持する技術が開示されている。

## 【0013】

さらに、従来例3として、特開平10-170958号公報の「カラー液晶表示装置」には、ゲート電極からブラックマトリックスへの電荷注入を減少させることにより、色付け層の電荷の蓄積を防止する技術が開示されている。この「カラー液晶表示装置」は、ブラックマトリックスの近傍のコラムの透過率を、ブラ

ックマトリックスの影響がない画素中央部のコラムの透過率に近づけることにより、ブラックマトリックスが横電界を乱すことがないようにするものであり、ブラックマトリックスの比抵抗と比誘電率及び液晶の比抵抗の関係を改善する定義を与えていた。

#### 【0014】

##### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来例1では、ブラックマトリックスの材料が限定され、単位膜当たりの光吸収率を大きくすることが困難であると共に、対向するTFT基板側の電位の偏りの影響をそのまま受けるので、ブラックマトリックスの電位が表示パネルの面内で変化し、これが表示ムラとして表れる。このような表示ムラを解消するために電位の平均化の点に配慮する必要があり、その配慮による設計変更は複雑化するという問題点があった。

#### 【0015】

また、上記従来例2では、ブラックマトリックスを周囲で露出させることが必要になるため、カラーフィルタの作製プロセスが複雑化するという問題点があった。

#### 【0016】

また、上記従来例3では、ゲート電極からブラックマトリックスへの電荷注入を減少させることは可能であるが、ブラックマトリックスから色層への電荷注入を防止することができないという問題点があった。

#### 【0017】

さらに、色層のチャージアップは、コントラストの低下や長期残像を引き起こすため、IPS(In Plane Switching mode) - LCD(横方向電界印加型-LCD、面内印加型-LCD)で発生する上記現象を低コストで防止することが望まれている。

#### 【0018】

本発明は、上記問題点に鑑みて成されたものであり、色層チャージアップに伴うコントラストの低下や残像現象を防止する液晶表示装置及びその製造方法を提供することにある。

## 【0019】

より詳細に、本発明は、対向基板のブラックマトリックス層に蓄積された電荷が横方向にリークするのを防止する液晶表示装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

## 【0020】

## 【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するために、請求項1記載の発明は、面内で横方向に電界が印加される横方向電界型の液晶表示装置において、第1の透明絶縁性基板と第2の透明絶縁性基板との層間に設けられる液晶層と、画素領域を形成するブラックマトリックス層と、画素領域の中に形成される色層とを有し、ブラックマトリックス層と色層との中央領域の間が高抵抗化されていることを特徴とする。

## 【0021】

請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、高抵抗化は、ブラックマトリックス層と色層とが基板に垂直な方向にオーバーラップしていないことを特徴とする。

## 【0022】

請求項3記載の発明は、請求項2記載の発明において、高抵抗化は、ブラックマトリックス層と色層との間に絶縁層が介設されていることを特徴とする。

## 【0023】

請求項4記載の発明は、請求項3記載の発明において、ブラックマトリックス層と色層とを被覆するオーバーコート層を有し、絶縁層は、オーバーコート層の一部により形成されることを特徴とする。

## 【0024】

請求項5記載の発明は、請求項3または4記載の発明において、絶縁層は、色層を形成する第1の材料と異なる他の色層により形成される第2の材料で形成され、第2の材料の比抵抗が第1の材料の比抵抗よりも高いことを特徴とする。

## 【0025】

請求項6記載の発明は、請求項3から5のいずれか1項に記載の発明において、絶縁層は、液晶層の一部であることを特徴とする。

【0026】

請求項7記載の発明は、請求項1から6のいずれか1項に記載の発明において、液晶層に電界を印加する電極層を形成する基板側に遮光層を有し、遮光層は、基板に垂直な方向で絶縁層にオーバーラップしていることを特徴とする。

【0027】

請求項8記載の発明は、請求項7記載の発明において、遮光層は、電極層であることを特徴とする。

【0028】

請求項9記載の発明は、面内で横方向に電界が印加される横方向電界型の液晶表示装置の製造方法において、第1の透明絶縁性基板と第2の透明絶縁性基板との層間に液晶層を設ける工程と、画素領域を形成するブラックマトリックス層を設ける工程と、画素領域の中に色層を設ける工程と、を有し、ブラックマトリックス層と色層との中央領域の間が高抵抗化されていることを特徴とする。

【0029】

請求項10記載の発明は、請求項9記載の発明において、高抵抗化は、ブラックマトリックス層と色層とが基板に垂直な方向にオーバーラップしていないことを特徴とする。

【0030】

請求項11記載の発明は、請求項10記載の発明において、高抵抗化は、ブラックマトリックス層と色層との間に絶縁層が介設されていることを特徴とする。

【0031】

請求項12記載の発明は、請求項11記載の発明において、ブラックマトリックス層と色層とを被覆するオーバーコート層を設ける工程を有し、絶縁層は、オーバーコート層の一部により形成されることを特徴とする。

【0032】

請求項13記載の発明は、請求項11または12記載の発明において、絶縁層は、色層を形成する第1の材料と異なる他の色層により形成される第2の材料で形成され、第2の材料の比抵抗が第1の材料の比抵抗よりも高いことを特徴とす

る。

【0033】

請求項14記載の発明は、請求項11から13のいずれか1項に記載の発明において、絶縁層は、液晶層の一部であることを特徴とする。

【0034】

請求項15記載の発明は、請求項9から14のいずれか1項に記載の発明において、液晶層に電界を印加する電極層を形成する基板側に遮光層を設ける工程を有し、遮光層は、基板に垂直な方向で絶縁層にオーバーラップしていることを特徴とする。

【0035】

請求項16記載の発明は、請求項15記載の発明において、遮光層は、電極層であることを特徴とする。

【0036】

〈作用〉

本発明は、このような高抵抗化により、ブラックマトリックスから色層に横方向に移動する電荷の流れが抑制され、液晶層が受ける悪影響が軽減される。

【0037】

高抵抗化は、幾何学的配置関係により有効に実現する。その幾何学的配置関係は、ブラックマトリックスと色層とが直交方向にオーバーラップしていないことであり、または、ブラックマトリックスと色層との横方向の間に横方向の絶縁層が介設されていることである。横方向絶縁層は、他の絶縁層であるオーバーコート層の一部が兼用され得る。この兼用は、製造プロセスのステップ数を削減することができる。

【0038】

この場合、横方向電界型液晶層とブラックマトリックスとの直交方向の間、及び、横方向電界型液晶層と色層との直交方向の間に介設されるオーバーコート層が設けられ、横方向絶縁層は、オーバーコート層の一部で形成されている。横方向絶縁層は、横方向電界型液晶層の一部であることも好ましい。

【0039】

横方向絶縁層は、色層（R，G，B）を形成する第1材料と異なり他の色層（R，G，B）を形成する第2材料で形成され、第2材料の比抵抗は第1材料の比抵抗よりも高いことが、課題解決のために有効である。例えば、色層（R，G，B）の色は、3原色RGBのうちのGであり、他の色層の色はRである。

#### 【0040】

横方向電界型液晶層に電界を印加する電極層を形成する基板の側に配置される遮光層が更に設けられる。遮光層は直交方向に横方向絶縁層にオーバーラップしている。高抵抗化は、ブラックマトリックスと色層とが直交方向にオーバーラップしていないことであり、且つ、ブラックマトリックスと色層との横方向の間に横方向絶縁層が介設される。

#### 【0041】

この場合、横方向絶縁層は実質的に不透明であることが好ましい。または、高抵抗化は、直交方向にブラックマトリックス層と色層とが僅かにオーバラップし、ブラックマトリックスと色層との横方向の間に横方向絶縁層が介設され、且つ、ブラックマトリックス層と色層との間の直交方向の間に直交方向絶縁層が介設されていることである。この場合、僅かにオーバーラップすることは、色層が横方向絶縁層に実質的に丁度重なり合う程度が好ましい。

#### 【0042】

##### 【発明の実施の形態】

次に、添付図面を参照しながら本発明の実施形態である液晶表示装置及びその製造方法を詳細に説明する。図1から図8を参照すると、本発明に係る液晶表示装置及びその製造方法の実施の形態が示されている。

#### 【0043】

##### 〈第1の実施形態〉

図1は、本発明の第1の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す断面図である。図1において、本発明の第1の実施形態である液晶表示装置は、第1偏光板1と、第2偏光板2と、CF（カラーフィルタ）硝子端子板3と、TFT（薄膜電界効果型トランジスタ）硝子端子板4と、色付け層5と、電界印加層6と、ブラックマトリックス層7と、色層8と、液晶層9と、オーバーコート層10

と、第1配向層11と、第2配向層12と、P A - S i N層13と、ソース電極層14と、ドレン電極層15と、n+a s i（アモルファスシリコン）層16と、a s i（アモルファスシリコン）層17と、絶縁層18と、ゲート電極層19と、により構成される。

## 【0044】

本発明の第1の実施形態である液晶表示装置は、2枚の偏光板（第1偏光板1、第2偏光板2）が設けられ、それらの間には、C F硝子端子板3とT F T硝子端子板4とが介設されている。C F硝子端子板3は、第1偏光板1に接合し、T F T硝子端子板4は、第2偏光板2にそれぞれ接合している。

## 【0045】

C F硝子端子板3とT F T硝子端子板4との間には、色付け層5と電界印加層6とオーバーコート層10とが介設されている。色付け層5は、C F硝子端子板3に接合し、電界印加層6は、T F T硝子端子板4に接合している。この色付け層5は、ブラックマトリックス層7と色層8とから形成されている。

## 【0046】

オーバーコート層10は、ブラックマトリックス層7且つ色層8の内側に配置され、ブラックマトリックス層7と色層8とのそれぞれに接合している。色層8が、R色フィルタ、G色フィルタ、B色フィルタである場合には、それぞれ色層8（R）、色層8（G）、色層8（B）と表される。

## 【0047】

ブラックマトリックス層7は、基板面に垂直な方向で色層8にオーバーラップしていない。基板面は、後述の液晶層9のダイレクタが向く方向を含む面に概ね平行な面として定義され、第1偏光板1と第2偏光板2とが対向する方向に直交する面として定義される。

## 【0048】

また、ブラックマトリックス層7は、基板面方向（基板面に含まれる2次元的方向）には色層8に直接接しておらず、図示されるように、ブラックマトリックス層7の端面（基板面に直交する面）と色層8の端面との間にはオーバーコート層10の一部が入り込んでいる。

## 【0049】

I P S型の液晶層9は、色付け層5と電界印加層6との間に介設されている。液晶層9と色付け層5との間には、第1配向層11が介設されている。液晶層9と電界印加層6との間には、第2配向層12が介設されている。

## 【0050】

電界印加層6は、PA-SiN層13と、ソース電極層14と、ドレイン電極層15と、n+asi層16と、asi層17と、絶縁層18と、ゲート電極層19と、から形成されている。

## 【0051】

PA-SiN層13は、第2配向層12の外側面側に形成され、ソース電極層14とドレイン電極層15とは、PA-SiN層13の外側面側に形成され、n+asi層16は、ソース電極層14とドレイン電極層15とのそれぞれの外側面側に形成されている。ここで、外側とは液晶表示装置の前側であり、図では上側に相当するものとする。

## 【0052】

asi層17は、n+asi層16の外側面側に形成され、両側でソース電極層14とドレイン電極層15とに挟まれて配置されている。絶縁層18は、asi層17とソース電極層14とのそれぞれの外側面側に形成されている。ゲート電極層19は、絶縁層18の一部の外側面側に形成され、当該絶縁層18とTFT硝子端子板4との間に挟まれて形成されている。

## 【0053】

図2は、本発明の第1の実施形態における単位液晶表示画素とその周辺近傍の透視図である。ソース電極層14は、単位画素領域の1つの方向に関する中央部で1つの閉じた格子状の画素電極24を形成している。この画素電極（ピクセル、P I）24の両側の極の横方向間に対向電極23が配置されている。対向電極23は、2格子状に形成されている。

## 【0054】

単位液晶表示画素の開口部26は、1点鎖線で示す単位格子のブラックマトリックス層により囲まれて遮蔽されている。ここで、ブラックとは、光学的に非透

過であることを意味する。

#### 【0055】

ゲート電極層19は、図2に示されるように、ゲート電極用走査線27Gに接続している。ドレイン電極層15は、ドレイン電極用信号線27Dに接続している。対向電極23と画素電極24とにより横方向電界が生成され、その横方向電界電圧が平面内配向の不図示の液晶層9に印加される。

#### 【0056】

このように電圧が印加された液晶層9は、その液晶の配向の主軸の向きが変わって、そこを通る白色光を偏光させる。電圧印加がない状態では、光透過率が極めて小さい第1偏光板1と第2偏光板2との間を通る光は外側に出ないが、電圧が印加された状態では、光透過率が零でなくなった両偏光板（第1偏光板及び第2偏光板2）の間を通る光は外側に出る。このように外側に出る光は、各カラー フィルタ8（R, G, B）により3原色化されている。

#### 【0057】

ゲート電極用走査線27Gとドレイン電極用信号線27Dとは、ブラックマトリックス層7に対して横方向電界の横方向に直交する直交方向Dに概ねオーバーラップしている。ブラックマトリックス層7は、液晶の横方向配向により形成される有効透過部（ブラックマトリックス層7により直交方向には囲まれる液晶部）22に対して斜め向きであり（ブラックマトリックス層7の中心線に有効透過部の中心領域を通って直交する直線は、直交方向Dに対して斜め向きであり）、ブラックマトリックス層7は、有効透過部22にに対して色層8よりも遠くに位置する。色層8は、その有効透過部22に対して基板面に概ね直交する直交方向Dに配置され、有効透過部22に対してブラックマトリックス層7よりも近くに配置されている。

#### 【0058】

ゲート電極とこの近傍の電極（以下、近傍電極といわれる）が生成する横方向電界電圧がブラックマトリックス層7に作用する。絶縁層により遮蔽されているブラックマトリックス層7は、電気的に中に浮いている。ブラックマトリックス層7が電界電圧の印加を受け、当該ブラックマトリックス層7とゲート電極・近

傍電極とは、直交方向Dに容量結合する。この容量結合により、ブラックマトリックス層7に電荷が蓄積される。ブラックマトリックス層7に蓄積される電荷は、当該ブラックマトリックス層7と色層8との横方向間の絶縁層である色付け層5の一部分に阻まれて移動しにくいので、有効透過部22の液晶の横方向配向は、色層8から受ける電界影響が小さく抑えられ、コントラストの低下や残像現象が抑制される。

## 【0059】

図3は、図2のI—I—I—I—I—I間の断面図である。図3に示されるように、画素電極24は、対向電極23の外側の層である上層として形成されている。画素電極24は、対向電極23からゲート絶縁膜25により絶縁されている。

## 【0060】

また、色層8(G)は、ブラックマトリックス層7に垂直な方向にはオーバーラップしていない。ブラックマトリックス層7と色層8(G)との間には、2次元横方向にオーバーコート層10の一部分が入り込んでいる。

## 【0061】

## 〈第2の実施形態〉

図4は、本発明の第2の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。本発明の第2の実施形態である液晶表示装置は、色層8とブラックマトリックス層7との横方向間に、オーバーコート層10の一部分だけでなく、液晶層9の一部分が介設されて入り込んでいる。この液晶層9を形成する比抵抗が著しく大きい液晶材料は、電荷注入をより良好に阻止することができる。

## 【0062】

## 〈第3の実施形態〉

図5は、本発明の第3の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。本発明の第3の実施形態である液晶表示装置は、ブラックマトリックス層7と色層8(R, G, B)との間である横方向間に、特別に選択された高比抵抗・不透明の材料の絶縁層50がそれぞれ介設されている。この絶縁層50は、直交方向に色層8とブラックマトリックス層7にオーバーラップするように配置されることが好ましい。絶縁層50は、一種のブラックマトリックスとして

の遮光性を有しているのでオーバーコート層10を形成しなくてもよい。

#### 【0063】

##### 〈第4の実施形態〉

図6は、本発明の第4の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。本発明の第4の実施形態は、ブラックマトリックス層7と色層8（R, G, B）との間である横方向間に、特別に選択された高比抵抗材料の絶縁層51がそれぞれに介設されている。絶縁層51は、直交方向Dにブラックマトリックス層7にオーバーラップすることが好ましい。

#### 【0064】

##### 〈第5の実施形態〉

図7は、本発明の第5の実施形態である液晶表示装置における絶縁層の構成例を示す断面図である。図7に示されるように、隣り合う2箇所の絶縁層51は、横方向に連続し、ブラックマトリックス層7を完全に被覆する絶縁層51'（R）として形成されることが好ましい。

#### 【0065】

##### 〈実施例〉

本発明の具体的な実施例を以下に詳述する。

横方向電界を利用するIPS方式の液晶表示装置の実施例は、液晶の比抵抗が10の13乗（Ω cm）以上である。ブラックマトリックス層7と色層8との横方向間に透明であるので、TFT基板（電極側基板）には、ブラックマトリックス層7に直交方向Dに十分にオーバーラップしてブラックマトリックス層の領域よりも広い領域に不透明電極が配置され、白色光の漏れが防止される。液晶の屈折率異方性で $\Delta n$ と液晶層のギャップ幅dとの積である位相回転角度差 $\Delta n d$ は、 $0.2 \mu m < \Delta n d < 0.36 \mu m$ である。ブラックマトリックス層7の抵抗が、色層8の抵抗に比べて十分に低い。

#### 【0066】

BM比抵抗（10の3乗～10の6乗Ω cm）

<<<色相R, G, B抵抗値（10の8乗～10の12乗Ω cm）

<オーバーコート層の抵抗値（10の14乗Ω cm以上）

## 【0067】

R, G, Bに関して、比抵抗Rは、下記の通りである。

R (R) = 10の10乗~10の12乗 ( $\Omega \text{ cm}$ )

R (G) = 10の9乗~10の11乗 ( $\Omega \text{ cm}$ )

R (B) = 10の8乗~10の12乗 ( $\Omega \text{ cm}$ )

R (OC) = 10の14乗  $\Omega \text{ cm}$  以上

R (図21の絶縁層50) = 10の14乗 ( $\Omega \text{ cm}$ ) 以上

ここで、OCはオーバーコート層10を示すものである。

## 【0068】

BMと8 (R) の間の絶縁層の比抵抗 R (R) = 10の12乗 ( $\Omega \text{ cm}$ )

BMと8 (G) の間の絶縁層の比抵抗 R (G) = 10の10乗 ( $\Omega \text{ cm}$ )

BMと8 (B) の間の絶縁層の比抵抗 R (B) = 10の9乗 ( $\Omega \text{ cm}$ )

## 【0069】

ブラックマトリックス層7と色層8とがオーバーラップしていない場合、光の漏れを抑制することが望まれる。図8は、電極23とブラックマトリックス層7とのオーバラッピングの状態及び電極23と色層8とのオーバラッピングの状態を示している。液晶層9の厚みはdで示され、対抗電極23の横方向幅がYで示されている。ブラックマトリックス層7と色層8との間に、オーバーコート層10の一部分である透明隙間61が形成されている。

## 【0070】

透明隙間61と対抗電極23とは、直交方向Dにオーバーラップしている。横方向幅Yが広いほど、透明隙間61を通過する漏れ光量は少なくなる。横方向幅Yが広いほど、開口率が低下して色層8を通過する有効光量が少なくなる。 $1 < d/Y < 7$ の関係を満たすことが有効である。特に、 $d = 5 \mu \text{m}$ 、 $Y = 2 \mu \text{m}$ 、であることが視覚経験上、特に有効である。

## 【0071】

また、色付き表示ムラが発生するカラーフィルタを用いた場合、液晶比抵抗が変化しても、短時間で輝度が一定値に落ち着く傾向がある。液晶比抵抗の変化は、電荷注入による色付き表示ムラ発生の原因に影響しない。色付き表示ムラ発生

の原因是、ブラックマトリックスとカラーフィルタとの間の電荷流動に強く依存している。

【0072】

なお、上述される実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、本発明の要旨を変更しない範囲内において種々変形して実施することが可能である。

【0073】

【発明の効果】

以上の説明より明らかなように、本発明による液晶表示装置及びその製造方法によれば、ブラックマトリックス層とカラーフィルタ（色層）とが平面的にオーバーラップしないようにレイアウトし、さらに、ブラックマトリックス層とカラーフィルタとの間を高抵抗層で充填するように構成することで、電荷注入を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。

【図2】

本発明の第1の実施形態である液晶表示装置の上面透視図である。

【図3】

図2のI—I—I—I—I—I線断面図である。

【図4】

本発明の第2の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。

【図5】

本発明の第3の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。

【図6】

本発明の第4の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。

【図7】

本発明の第5の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。

【図8】

本発明の第6の実施形態である液晶表示装置の概略構成を示す正面断面図である。

【図9】

従来の液晶表示装置の概略構成を示す断面図である。

【図10】

従来の液晶表示装置における等価電気回路を示す回路図である。

【図11】

従来の液晶表示装置の他の概略構成を示す断面図である。

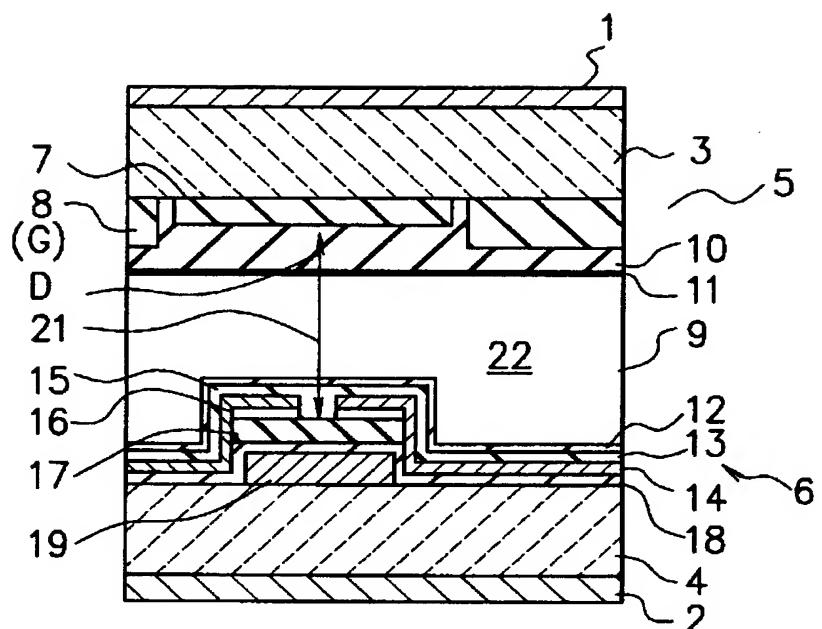
【符号の説明】

- 1 第1偏光板
- 2 第2偏光板
- 3 第1C F（カラーフィルタ）硝子端子板
- 4 T F T（薄膜トランジスタ）硝子端子遺体
- 5 色付け層
- 6 電界印加層
- 7 ブラックマトリックス
- 8 (R, G, B) 色層
- 9 横方向電界型液晶層
- 10 オーバーコート層
- 11 第1配向層
- 12 第2配向層
- 13 P a - S i N層
- 14 ソース電極層
- 15 ドレイン電極層
- 16 N a s i層

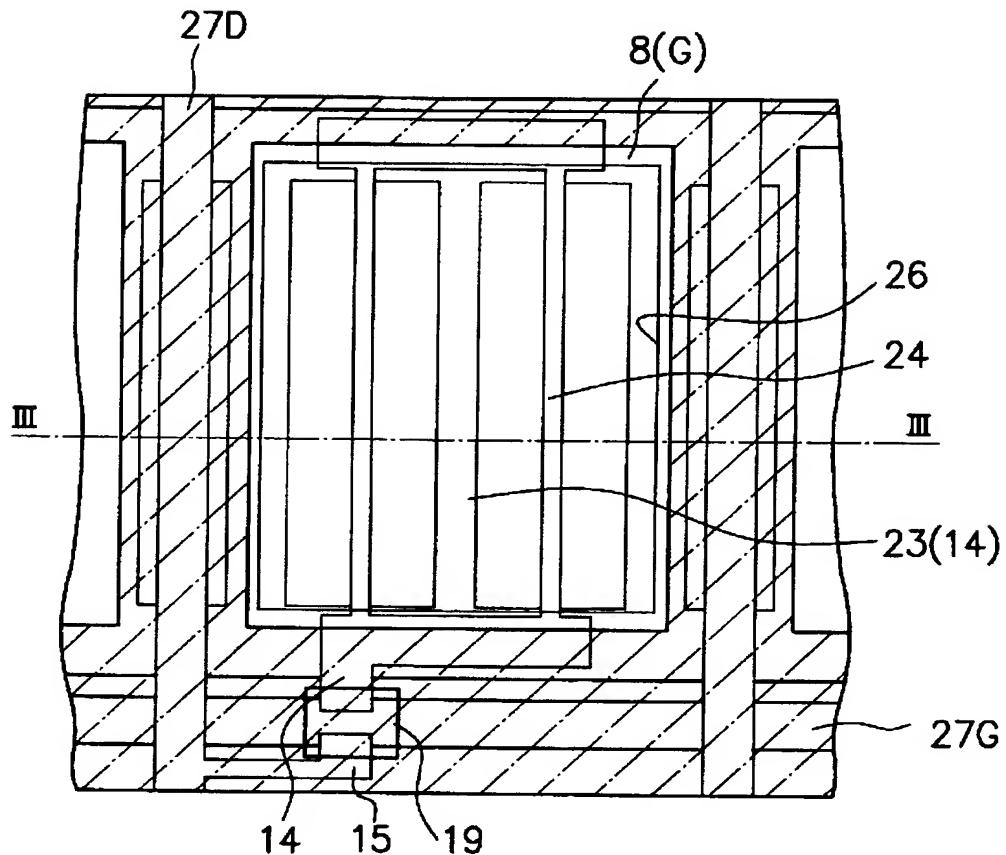
- 1 7 a s i層
- 1 8 絶縁層
- 1 9 ゲート電極層
- 2 1 容量結合
- 2 2 有効透過部
- 2 3 対向電極
- 2 4 画素電極
- 2 5 ゲート絶縁膜
- 2 6 開口部
- D 直交方向

【書類名】 図面

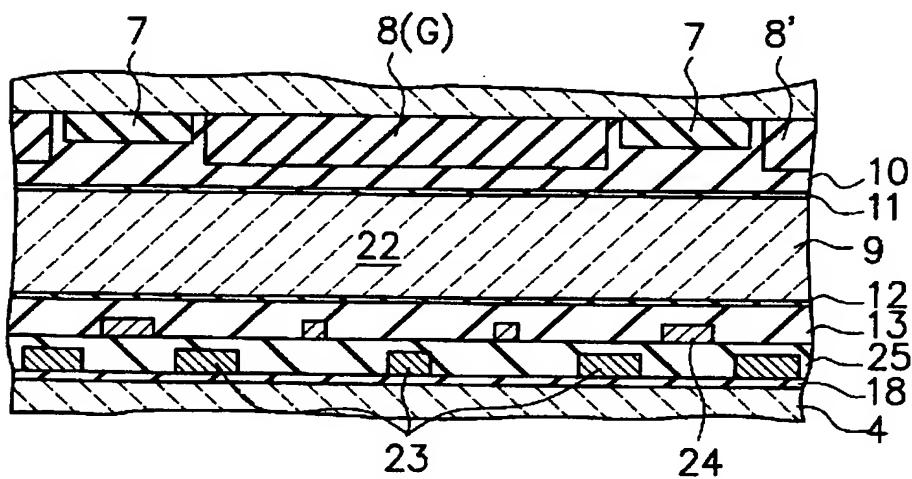
【図1】



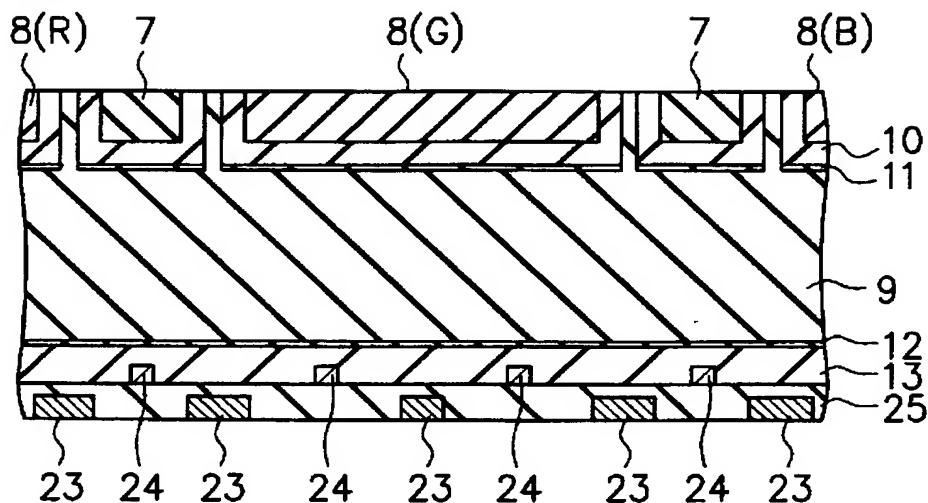
【図2】



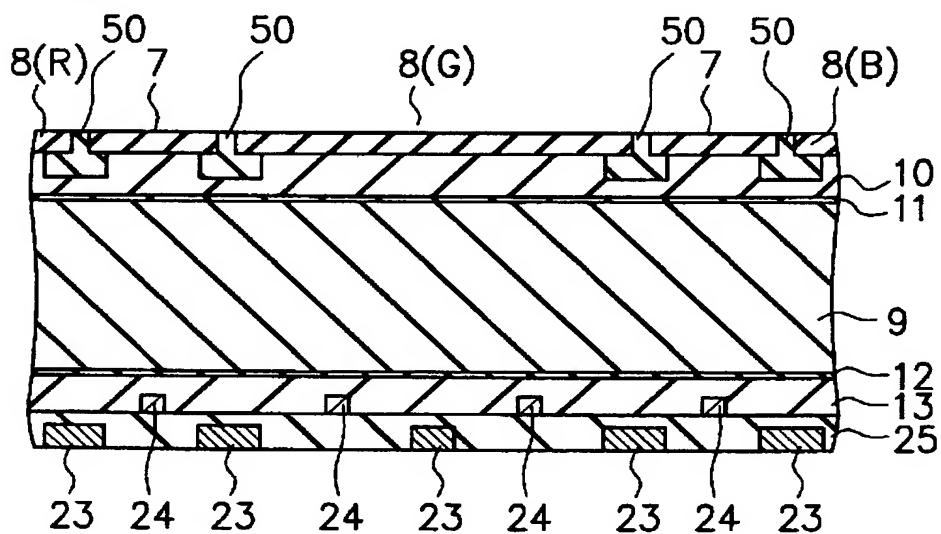
【図3】



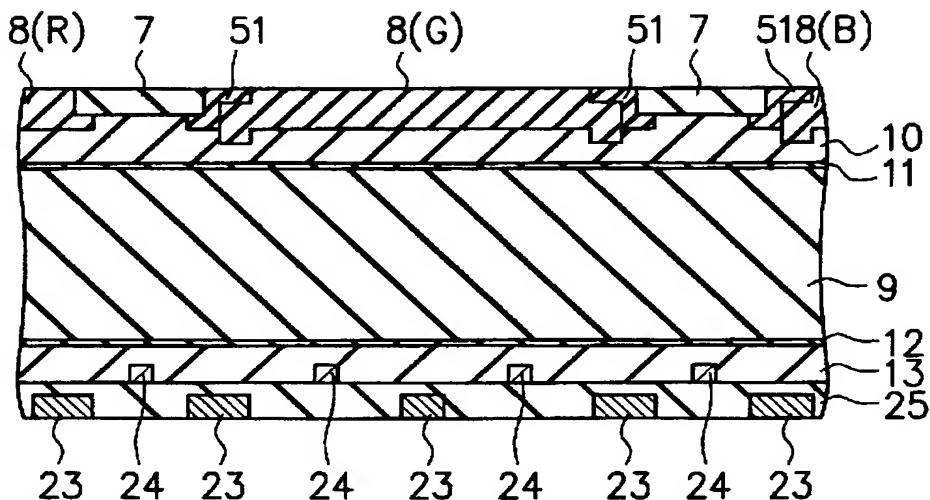
【図4】



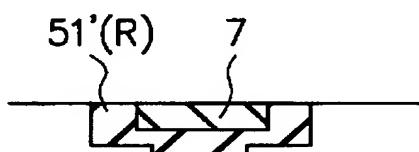
【図5】



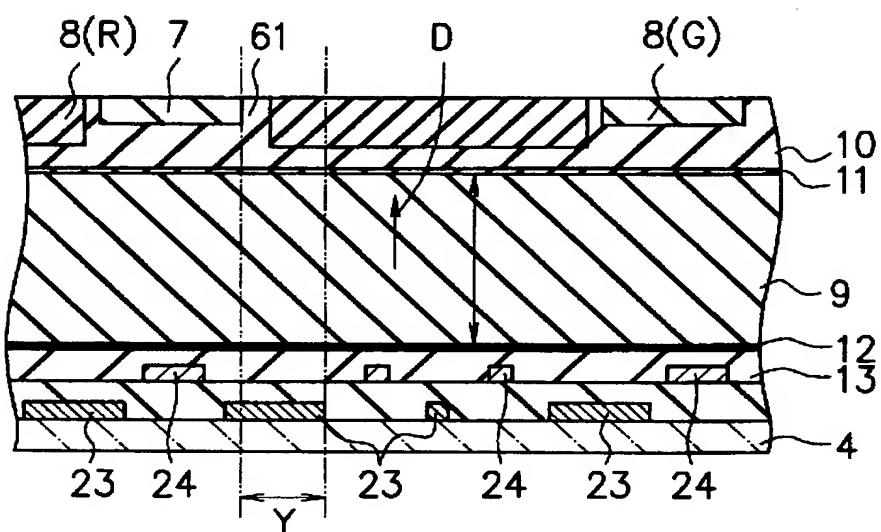
【図6】



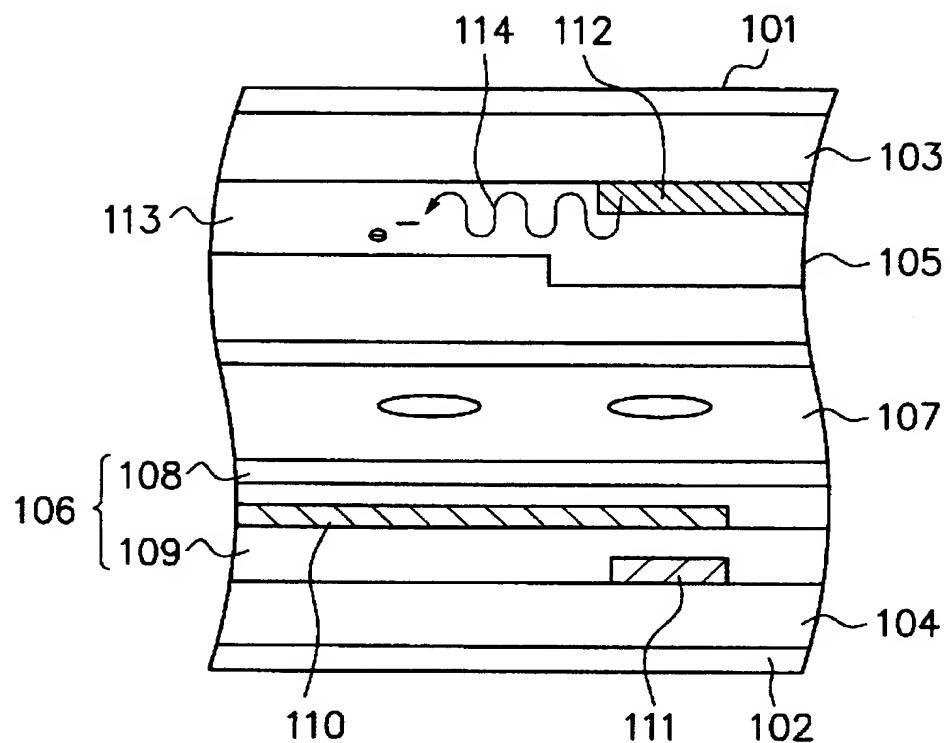
【図7】



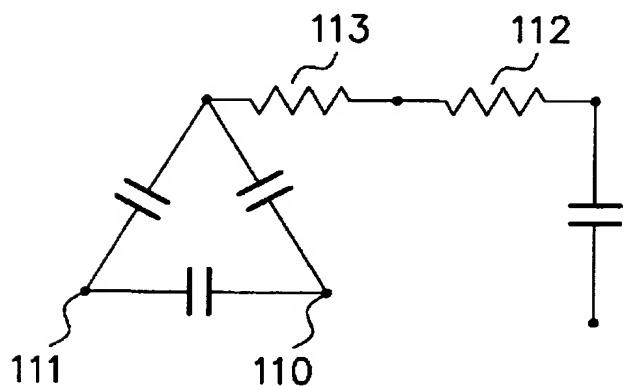
【図8】



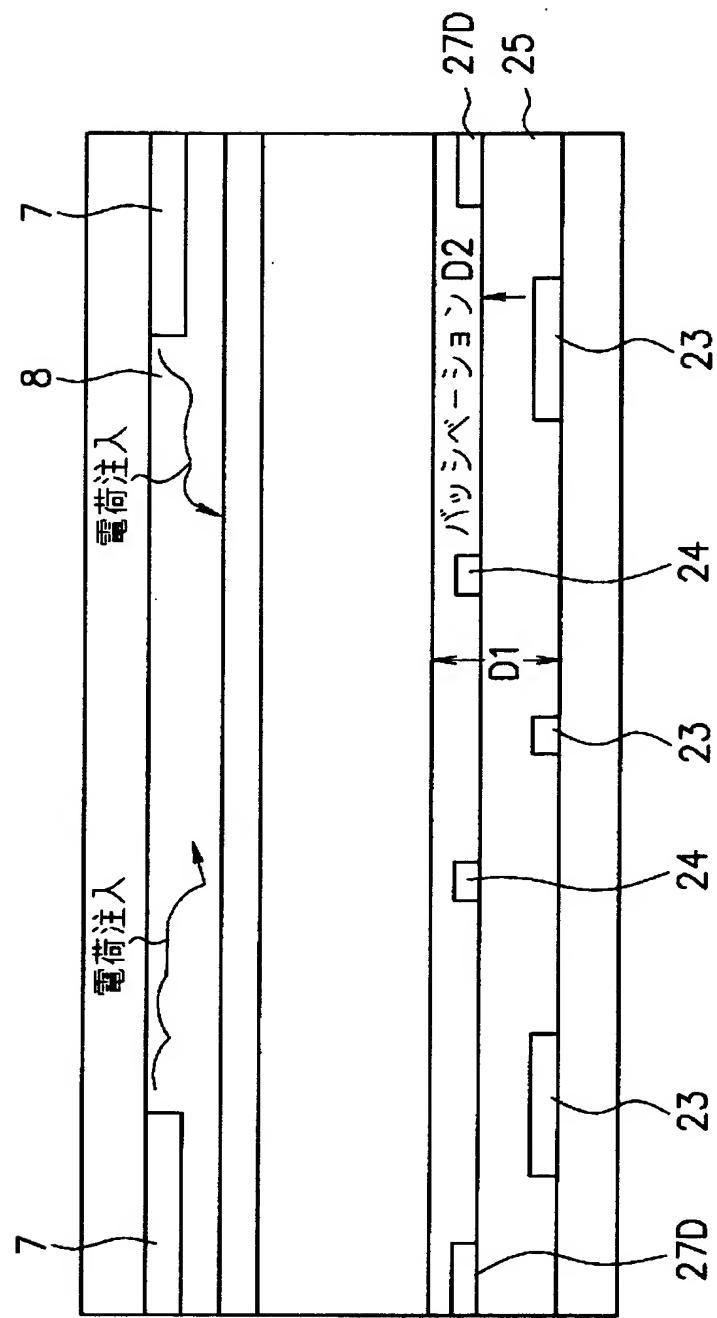
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 色層チャージアップに伴うコントラストの低下や残像現象を防止する液晶表示装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明の第1の実施形態である液晶表示装置は、第1偏光板1と、第2偏光板2と、CFT硝子端子板3と、TFT硝子端子板4と、色付け層5と、電界印加層6と、ブラックマトリックス層7と、色層8と、液晶層9と、オーバーコート層10と、第1配向層11と、第2配向層12と、PA-SiN層13と、ソース電極層14と、ドレイン電極層15と、n+asil層16と、asil層17と、絶縁層18と、ゲート電極層19と、から構成される。ブラックマトリックス層とカラーフィルタ（色層）とが平面的にオーバーラップしないようにレイアウトし、さらに、ブラックマトリックス層とカラーフィルタとの間を高抵抗層で充填するようにすることで、横方向に移動する電荷の流れを抑制できるので、液晶層が受ける悪影響を軽減することができる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名 日本電気株式会社



Creation date: 10-07-2003

Indexing Officer: PHOENIX - PHOENIX

Team: PhxAdministrator

Dossier: 10055127

Legal Date: 16-04-2003

No.	Doccode	Number of pages
1	SRNT	2

Total number of pages: 2

Remarks:

Order of re-scan issued on .....